



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体二极管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes

1SS181 (SWITCHING DIODE)

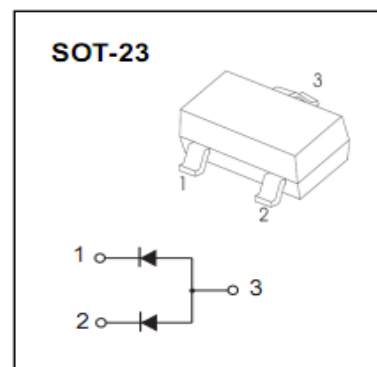
特点/Features:

低导通压降;
反向恢复时间短

用途/Applications:

高速开关电路。

印章/Marking: A3



极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25℃)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
反向峰值电压/Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RM}	85	V
反向电压/Reverse Voltage	V_R	80	V
正向连续电流/Forward Continuous Current	I_F	300	mA
平均整流输出电流/Average Rectified Output Current	I_O	100	mA
功率/ Power Dissipation	P_D	0.15	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	℃
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	℃

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25℃)

参数/Parsmeter	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage	V_R	$I_R=100\ \mu A$	80			V
正向电压 Forward Voltage	V_{F1}	$I_F=1mA$		0.61		V
	V_{F2}	$I_F=10mA$		0.74		V
	V_{F3}	$I_F=100mA$		0.92	1.2	μA
反向漏电流 Reverse Current	I_{R1}	$V_R=30V$			0.1	μA
	I_{R2}	$V_R=80V$			0.5	μA
端电容 Capacitance Between Terminals	C_T	$V_R=0, f=1MHz$		2.2	4.0	pF
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=I_R=10mA,$ $I_{rr}=0.1 \times I_R$		1.6	4.0	nS



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体二极管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes

典型特性曲线图/Typical Characteristics

